

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
главного научного сотрудника – заведующего лабораторией
в лаборатории Фотоэлектрических явлений в полупроводниках
Вакансия VAC_26722

Тематика исследований

Исследования и разработки в области фотоэлектрических и оптических явлений в полупроводниковых структурах, включая наноструктуры с различной степенью разупорядочения: полупроводниковые твердые растворы, стеклообразные полупроводники и углеродные структуры, а также в биообъектах.).

Трудовая деятельность

Осуществление научного руководства конкретными темами исследований согласно государственному заданию и планам НИР по утверждённым целевым программам, а также подготовка и подача заявок на новые проекты в рамках базового бюджетного и целевого финансирования; руководство работой сотрудников, выполняющих эти исследования, и обеспечение выполнения ими правил внутреннего распорядка в учреждении. Непосредственное участие в выполнении исследований: разработка методов решения наиболее сложных научных проблем; обоснование направлений новых исследований и разработок, предложений к программам и планам научно-исследовательских работ; организация разработки новых научных проектов; координация деятельности соисполнителей работ; обеспечение анализа и обобщения полученных результатов, предложение сферы их применения. Осуществление подготовки научных кадров, участие в повышении их квалификации, а также в подготовке специалистов с высшим образованием в соответствующей области (руководство дипломными и курсовыми работами).

Особенности трудовой деятельности:

главный научный сотрудник – заведующий лабораторией Фотоэлектрических явлений в полупроводниках несет полную материальную ответственность за имущество, закрепленное за лабораторией, а также работает со сведениями, составляющими государственную тайну по ф. 3.

С целью обеспечения поддержания уровня исследований в лаборатории Фотоэлектрических явлений в полупроводниках на уровне, не ниже достигнутого в настоящее время, при оценке кандидатов комиссия будет исходить из следующих минимальных требований к квалификации кандидатов.

- Наличие ученой степени доктора физико-математических наук.
- Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений не менее 150
в том числе:

- опубликованных произведений (шт.) 150

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности не менее 2, в том числе:

- имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в РФ (шт.) не менее 1
- имеющих правовую охрану за пределами Российской Федерации (шт.) не менее 1

-- Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования не менее:

- Web of Science (шт.) 100
- Scopus (шт.) 100
- Российский индекс научного цитирования (шт.) 150

-- Индекс Хирша по базе РИНЦ не ниже 12.

-- Опыт научной работы не менее 15 лет.

-- Опыт научно-организаторской работы не менее 3 лет.

-- За последние 5 лет подготовка не менее 5 научных кадров высшей квалификации (магистров)

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- личный листок по учету кадров;
- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса;
- характеристика с последнего места работы.

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, заместителю директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе А.Б. Подласкину, телефон для справок: (812)2927196.

Настоящие требования к кандидатам и перечень необходимых документов опубликованы на веб-сайте ФТИ им. А.Ф. Иоффе (<http://www.ioffe.ru>).